

Приложение 4 Фонд оценочных средств учебных дисциплин
к ОПОП по специальности
10.02.05 Обеспечение информационной
безопасности автоматизированных систем

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И БЛОКИ ПИТАНИЯ

Регистрационный №23ИБ/ 34_ФОС

Санкт-Петербург
2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ФОРМА И УСЛОВИЯ АТТЕСТАЦИИ.....	4
3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К АТТЕСТАЦИИ.	18

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с требованиями образовательно программы подготовки специалистов среднего звена (ОП ПССЗ) и Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, утвержденного Приказом Министерства образования и науки от 09.12.2016 № 1553.

Фонд оценочных средств предназначен для оценки достижения запланированных по дисциплине **ОП.11 Основы электротехники и блоки питания** результатов обучения.

ФОС включает контрольные оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

1.1.Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ПК 1.4 ОК 1,2,4-6,9	уметь: <ul style="list-style-type: none">- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов;- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;- снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими;- собирать электрические схемы;- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.	знать: <ul style="list-style-type: none">- основные законы электротехники;- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин;- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;- параметры электрических схем и единицы их измерения;- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов;- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;- способы получения, передачи и использования электрической энергии;- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;- характеристики и параметры электрических и магнитных полей.

1.2. Контингент аттестуемых

Контингент аттестуемых - студенты 2 курса.

2.ФОРМА И УСЛОВИЯ АТТЕСТАЦИИ

Название дисциплины	Форма контроля оценивания	
	Промежуточная аттестация	Текущий контроль
ОП.11 Основы электротехники и блоки питания	2 курс 3 семестр Дифференцированный зачет	Оценка результатов выполнения практических работ

2.1 Задания для текущего контроля

Практические/лабораторные работы

Практическое занятие 1	Расчет электрических цепей при последовательном, параллельном и смешанном соединение резисторов
Практическое занятие 2	Методы расчета электрических цепей. Решение задач методом применения законов Кирхгофа.
Практическое занятие 3	Решение задач на неразветвленные электрические RLC – цепи с построением векторных диаграмм.
Практическое занятие 4	Схема управления трехфазным двигателем с короткозамкнутым ротором
Практическое занятие 5	Исследование режимов работы трансформаторов.

2.2 Задания для промежуточной аттестации- Дифференцированный зачет

Дифференциальный зачет проводиться в виде тестирования

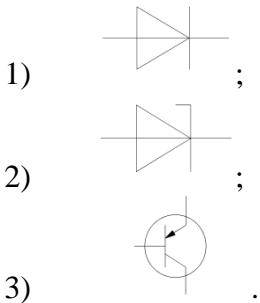
Тестовые задания
к диф. Зачету по дисциплине “ Основы электротехники и блоки питания»

Вариант 1

1. Полупроводниковый диод это:

- 1) полупроводниковый прибор с двумя р-п-переходами, имеющий три вывода;
- 2) полупроводниковый прибор с одним электронно-дырочным переходом, имеющий два вывода;
- 3) полупроводниковый прибор с одним электронно-дырочным переходом, имеющий три и более выводами.

2. Условное графическое обозначение стабилитрона:



3. При прямом включении р-п-перехода запирающий слой:

- 1) исчезает;
- 2) расширяется;
- 3) не изменяется.

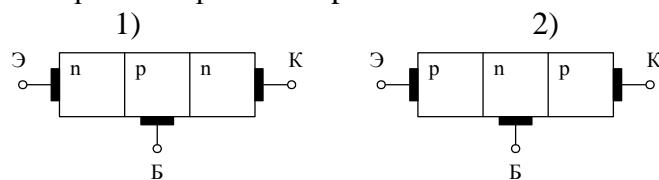
4. Туннельный пробой возникает:

- 1) в широких переходах с незначительной концентрацией примесей;
- 2) в узких переходах с большой концентрацией примесей;
- 3) в узких переходах с незначительной концентрацией примесей;
- 4) в широких переходах с большой концентрацией примесей.

5. Основное назначение биполярного транзистора:

- 1) ограничение электрических сигналов;
- 2) усиление электрических сигналов;
- 3) переключение электрических сигналов.

6. Структура биполярного транзистора типа n-p-n:



7. Физический смысл параметра h_{12} :

- 1) коэффициент обратной передачи по напряжению;
- 2) выходная проводимость;
- 3) коэффициент прямой передачи по току;
- 4) входное сопротивление.

8. Эмиттерный переход биполярного транзистора открыт, а коллекторный закрыт. В каком режиме работает транзистор:

- 1) режиме насыщения;
- 2) режиме отсечки;
- 3) нормальном активном режиме;
- 4) инверсном активном режиме.

9. Основной зависимостью, описывающей взаимосвязь токов и напряжений транзисторов в динамическом режиме, является:

- 1) входная нагрузочная характеристика;
- 2) выходная нагрузочная характеристика;
- 3) выходная статическая характеристика.

10. Усилительным устройством или усилителем называется:

- 1) устройство, в нагрузку которого поступает усиленный по напряжению входной сигнал;
- 2) устройство, в нагрузку которого поступает усиленный по мощности за счет энергии внешнего источника питания входной сигнал;
- 3) устройство, в нагрузку которого поступает усиленный по мощности за счет собственной энергии входной сигнала.

11. Отрицательная обратная связь:

- 1) увеличивает;
 - 2) оставляет неизменным;
 - 3) уменьшает
- полосу пропускания усилителя.

12. Операционным усилителем называют:

- 1) каскадный;
- 2) дифференциальный;
- 3) резонансный.

усилитель постоянного тока с очень высоким коэффициентом усиления и несимметричным выходом.

13. Нижняя граничная частота активного ФВЧ:

- 1) $\omega_h = RC$;
- 2) $f_h = 1/RC$;
- 3) $f_h = 1/(2\pi RC)$.

где R и C - сопротивление и емкость пассивных элементов в прямой ветви.

14. АЦП преобразует:

- 1) аналогичную величину в цифровой код;
- 2) цифровой код в аналоговую величину;
- 3) линейно-изменяющееся напряжение в ступенчато-изменяющееся напряжение.

Тест
к Диф.зачёту по дисциплине “ Основы электротехники и блоки питания»

Вариант 2

1 Основное свойство полупроводникового диода это:

- 1) свойство усиления электрического сигнала;
- 2) свойство односторонней проводимости;
- 3) свойство ограничения амплитуды электрического сигнала.

2. Условное графическое обозначение выпрямительного диода:

- 1)  ;
- 2)  ;
- 3)  .

3. Какое из перечисленных свойств определяет область применения туннельных и обращенных диодов:

- 1) наличие емкости;
- 2) явление пробоя;
- 3) туннельный эффект;
- 4) свечение при протекании электрического тока.

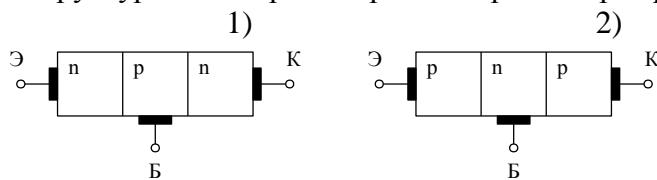
4. Лавинный пробой возникает:

- 1) в узких переходах за счет ударной ионизации;
- 2) в широких переходах за счет ударной ионизации.

5. В основу функционирования биполярного транзистора положены процессы токопрохождения, вызванные:

- 1) носителями заряда одного типа;
- 2) носителями заряда двух типов;
- 3) носителями зарядов трех типов.

6. Структура биполярного транзистора типа р-п-р:



7. Физический смысл параметра μ :

- 1) внутреннее (дифференциальное) сопротивление;
- 2) крутизна характеристики передачи;
- 3) статический коэффициент усиления по напряжению.

8. В каком типе полевого транзистора области истока и стока соединяются узким каналом в процессе производства:

- 1) с индуцированным каналом;
- 2) со встроенным каналом;

3) с управляющим p-n-переходом.

9. Для построения выходной нагрузочной характеристики транзисторных усилителей на семействе выходных статических характеристик достаточно иметь:

- 1) две точки;
- 2) одну точку;
- 3) три точки.

10. При последовательном соединении усилителей с коэффициентами усиления по напряжению K_1, K_2, \dots, K_N результирующий коэффициента усиления в разах равен:

$$1) \quad K_p = \prod_{n=1}^N K_n; \quad 2) \quad K_p = 20 \sum_{n=1}^N \lg K_n; \quad 3) \quad K_p = \sum_{n=1}^N K_n.$$

11. Отрицательная обратная связь:

- 1) увеличивает;
- 2) оставляет неизменным;
- 3) уменьшает
нелинейные искажения сигналов в усилителе.

12. Усилильными параметрами ОУ являются:

- 1) $K; R_{bx}; R_{bx\ cp}; K_{cp}; K_{oc\ cp}; R_{vых};$
- 2) $U_{ch}; T K U_{ch}; I_{bx}; \Delta I_{bx};$
- 3) $f_l; f_b; V_{max}; t_y; t_b.$

13. Входное сопротивление неинвертирующего усилителя на ОУ равно:

- 1) входному сопротивлению ОУ $R_{bx};$

- 2) сопротивлению в прямой цепи ОУ;

- 3) $R_{bx}(1 + \beta K).$

14. ЦАП преобразует:

- 1) аналогичную величину в цифровой код;
- 2) цифровой код в аналоговую величину;
- 3) линейно-изменяющееся напряжение в ступенчато-изменяющееся напряжение.

Тест

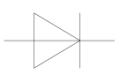
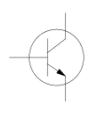
к Диф.зачёту по дисциплине “ Основы электротехники и блоки питания”

Вариант 3

1 P-n-переход это:

- 1) зона контакта двух областей полупроводника с различными типами проводимости;
- 2) зона контакта металла и полупроводника n-типа;
- 3) зона контакта металла и полупроводника p-типа.

2 Условное графическое обозначение варикапа:

- 1)  ;
- 2)  ;
- 3)  .

3. Обратное включение р-п-перехода получается при подключении внешнего источника напряжения:

- 1) минусом к р-области, плюсом к н-области;
- 2) минусом к н-области, плюсом к р-области.

4. Термовой пробой возникает:

- 1) за счет разогрева перехода при резком увеличении прямого тока;
- 2) за счет разогрева перехода при резком увеличении обратного тока.

5. Биполярный транзистор содержит:

- 1) не менее двух р-п-переходов;
- 2) один р-п-переход;
- 3) три р-п-перехода.

6. Структура биполярного транзистора типа р-п-р:



7.. Физический смысл параметра h_{21} :

- 1) коэффициент обратной передачи по напряжению;
- 2) выходная проводимость;
- 3) коэффициент прямой передачи по току;
- 4) входное сопротивление.

8. Эммитерный переход биполярного транзистора закрыт, а коллекторный открыт. В каком режиме работает транзистор:

- 1) режиме насыщения;
- 2) режиме отсечки;
- 3) нормальном активном режиме;
- 4) инверсном активном режиме.

9. Логический элемент И-НЕ с простым инвертором является базовым логическим элементом:

- 1) ЭСЛ;
- 2) ТТЛ;
- 3) И²Л.

10. При последовательном соединении усилительных каскадов со сдвигами фаз $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_N$ результирующий сдвиг фазы φ_p усилителя равен:

$$1) \varphi_p = \sum_{n=1}^N \varphi_n. \quad 2) \varphi_p = \prod_{n=1}^N \varphi_n; \quad 3) \varphi_p = \varphi_1 = \varphi_2 = \dots = \varphi_N.$$

11. Отрицательная обратная связь:

- 1) увеличивает;
 - 2) оставляет неизменным;
 - 3) уменьшает
- стабильность коэффициента усиления.

12. Точностными параметрами ОУ являются:

- 1) $K; R_{bx}; R_{bx\ cp}; K_{cp}; K_{oc\ cp}; R_{vых};$

- 2) U_{ch} ; TKU_{ch} ; I_{bx} ; ΔI_{bx} ;
 3) f_1 ; f_b ; V_{max} ; t_y ; t_b .

13. Коэффициент передачи активного неинвертирующего ФВЧ в области СЧ:

- 1) $K = -R_{oc}/R$; 2) $K = 1+R_{oc}/R$; 3) $K = 1$,

где R_{oc} - сопротивление в цепи обратной связи; R - сопротивление в прямой цепи.

14. Основные статические параметры АЦП и ЦАП определяются с помощью:

- 1) амплитудно-частотной характеристики;
 2) статической характеристики преобразования;
 3) выходной характеристики преобразователя.

Тест
к Диф.зачёту по дисциплине “ Основы электротехники и блоки питания”

Вариант 4

1. Какие параметры полупроводниковых диодов являются общими для любых типов диодов:

- 1) основные;
 2) предельно-допустимые;
 3) частные (для конкретных диодов).

2 Условное графическое обозначение светодиода:

- 1)  ;
 2)  .
 3)  .

3. Какое из перечисленных свойств определяет область применения варикапа:

- 1) наличие емкости;
 2) явление пробоя;
 3) туннельный эффект;
 4) свечение при протекании электрического тока.

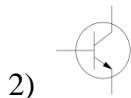
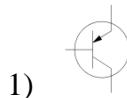
4. Инжекция носителей заряда это:

- 1) введение основных носителей заряда через границу р-п-перехода при его прямом включении;
 2) выведение неосновных носителей заряда через границу р-п-перехода при его обратном включении;
 3) воссоединение носителей заряда противоположных знаков.

5. В основу функционирования полевого транзистора положены процессы токопрохождения, вызванные:

- 1) носителями заряда одного типа;
 2) носителями заряда двух типов;
 3) носителями заряда трех типов.

6. Структура биполярного транзистора типа п-р-п:



7. Физический смысл параметра h_{22} :

- 1) коэффициент обратной передачи по напряжению;
- 2) выходная проводимость;
- 3) коэффициент прямой передачи по току;
- 4) входное сопротивление.

8. В каком типе полевого транзистора в исходном состоянии области истока и стока не соединены между собой:

- 1) с индуцированным каналом;
- 2) со встроенным каналом;
- 3) с управляющим p-n-переходом.

9. Побудительными мотивами для усовершенствования логических элементов ТТЛ явилось стремление:

- 1) увеличить помехоустойчивость и нагрузочную способность;
- 2) повысить быстродействие и понизить потребляемую мощность;
- 3) повысить быстродействие.

10. Переходной характеристикой усилителя называют зависимость от времени мгновенного значения:

- 1) коэффициента усиления усилителя;
 - 2) выходного напряжения усилителя;
 - 3) выходного сопротивления усилителя
- при мгновенном скачкообразном изменении напряжения на входе усилителя.

11. Отрицательная обратная связь:

- 1) увеличивает;
 - 2) оставляет неизменным;
 - 3) уменьшает
- коэффициент усиления усилителя.

12. Коэффициент усиления повторителя на ОУ равен:

- 1) $K > 1$;
- 2) $K = 1$;
- 3) $K < 1$.

13. Коэффициент передачи активного инвертирующего ФНЧ в области СЧ:

- 1) $K = -R_{oc}/R$;
- 2) $K = 1+R_{oc}/R$;
- 3) $K = 1$,

где R_{oc} - сопротивление в цепи обратной связи; R - сопротивление в прямой цепи.

14. Какой из перечисленных типов преобразователей не относится к АЦП:

- 1) последовательного счета;
- 2) на матрице R-2R;
- 3) поразрядного кодирования;
- 4) параллельный.

Тест

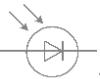
к Диф.зачёту по дисциплине ““ Основы электротехники и блоки питания»

Вариант 5

1. Прямое включение р-п-перехода получается при подключении внешнего источника напряжения:

- 1) минусом к р-области, плюсом к п-области;
- 2) минусом к п-области, плюсом к р-области.

2. Условное графическое обозначение фотодиода:

- 1)  ;
- 2)  ;
- 3)  .

3. При обратном включении р-п-перехода запирающий слой:

- 1) исчезает;
- 2) расширяется;
- 3) не изменяется.

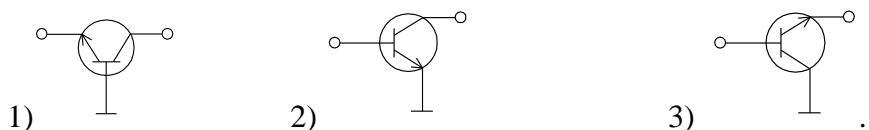
4. Экстракция носителей заряда это:

- 1) введение основных носителей заряда через границу р-п-перехода при его прямом включении;
- 2) выведение неосновных носителей заряда через границу р-п-перехода при его обратном включении;
- 3) воссоединение носителей заряда противоположных знаков.

5. Выводы биполярного транзистора называются:

- 1) исток, затвор, сток;
- 2) эммитер, база, коллектор;
- 3) анод, сетка, катод.

6. Схема включения БТ с ОЭ:



7. Физический смысл параметра S:

- 1) внутреннее (дифференциальное) сопротивление;
- 2) крутизна характеристики передачи;
- 3) статический коэффициент усиления по напряжению.

8. Эммитерный и коллекторный переходы биполярного транзистора закрыты. В каком режиме работает транзистор:

- 1) режиме насыщения;
- 2) режиме отсечки;
- 3) нормальном активном режиме;
- 4) инверсном активном режиме.

9. Основы базового логического элемента КМОП составляют:

- 1) инвертор на комплементарных биполярных транзисторах;
- 2) инвертор на комплементарных МОП-транзисторах;
- 3) инвертор на п-канальных МОП-транзисторах.

10. При последовательном соединении усилителей с коэффициентами усиления по напряжению K_1, K_2, \dots, K_N результирующий коэффициент усиления K_p в дБ равен:

$$1) K_p = \prod_{n=1}^N K_n; \quad 2) K_p = 20 \sum_{n=1}^N \lg K_n; \quad 3) K_p = \sum_{n=1}^N K_n.$$

11. При отрицательной обратной связи:

$$1) \varphi_{вх} - \varphi_{вых} = 0^0; \quad 2) \varphi_{вх} - \varphi_{вых} = 90^0; \quad 3) \varphi_{вх} - \varphi_{вых} = 180^0.$$

12. Динамическими параметрами ОУ являются:

- 1) $K; R_{вх}; R_{вх\,cp}; K_{cp}; K_{oc\,cp}; R_{вых};$
- 2) $U_{ch}; T(K)U_{ch}; I_{вх}; \Delta I_{вх};$
- 3) $f_l; f_b; V_{max}; t_y; t_b.$

13. Коэффициент усиления инвертирующего усилителя на ОУ:

$$1) K = -R_{oc}/R; \quad 2) K = 1 + R_{oc}/R; \quad 3) K = 1.$$

где R_{oc} - сопротивление в цепи обратной связи; R - сопротивление в прямой цепи.

14. Какой из перечисленных типов преобразователей не относится к ЦАП:

- 1) на матрице резисторов с весовыми сопротивлениями;
- 2) на матрице резисторов R-2R;
- 3) параллельный.

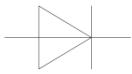
Тест
к Диф.зачёту по дисциплине « Основы электротехники и блоки питания»

Вариант 6

1. Какое из перечисленных свойств определяет область применения полупроводникового стабилитрона:

- 1) наличие емкости;
- 2) явление пробоя;
- 3) туннельный эффект;
- 4) свечение при протекании электронного тока.

2. Условное графическое обозначение обращенного диода:

- 1)  ;
- 2)  ;
- 3)  .

3. Какое из перечисленных свойств определяет область применения фотодиодов:

- 1) наличие емкости;
- 2) явление пробоя;

- 3) чувствительность к внешним воздействиям;
- 4) свечение при протекании электрического тока.

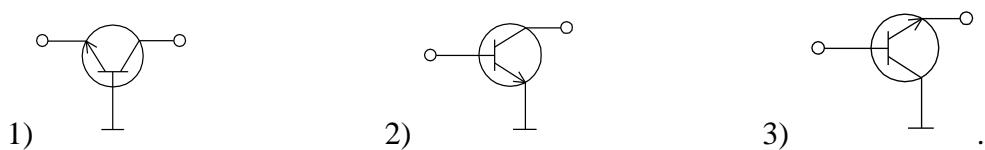
4. Рекомбинация носителей заряда это:

- 1) введение основных носителей заряда через границу р-п-перехода при его прямом включении;
- 2) выведение неосновных носителей заряда через границу р-п-перехода при его обратном включении;
- 3) воссоединение носителей заряда противоположных знаков.

5. Выводы полевого транзистора называются:

- 1) исток, затвор, сток;
- 2) эмиттер, база, коллектор;
- 3) анод, сетка, катод.

6. Схема включения БТ с ОК:



7. Физический смысл параметра h_{11} :

- 1) коэффициент обратной передачи по напряжению;
- 2) выходная проводимость;
- 3) коэффициент прямой передачи по току;
- 4) входное сопротивление.

8. Принцип действия какого типа полевых транзисторов основан на изменении сечения его канала с помощью двух обратно смещенных р-п-переходов:

- 1) с индуцированным каналом;
- 2) со встроенным каналом;
- 3) с управляемым р-п-переходом.

9. В статическом режиме ток через базовый логический элемент КМОП не течет. К какому достоинству это приводит:

- 1) большая помехоустойчивость;
- 2) нулевая мощность потребления в статическом режиме;
- 3) большая нагрузочная способность.

10. Полосой пропускания усилителя называют диапазон частот, в пределах которого модуль комплексного коэффициента усиления К усилителя:

- 1) меньше $0,707 K_{max}$;
- 2) равен K_{max} ;
- 3) больше $0,707 K_{max}$.

11. Отрицательная обратная связь:

- 1) увеличивает;
 - 2) оставляет неизменным;
 - 3) уменьшает
- нелинейные искажения сигналов в усилителе.

12. Входное сопротивление инвертирующего усилителя на ОУ равно:

- 1) входному сопротивлению ОУ;

- 2) сопротивлению в прямой цепи ОУ;
3) бесконечности.

13. Верхняя граничная частота активного ФНЧ:

- 1) $f_B = 1/(2\pi R_{oc} C_{oc})$;
2) $\omega_B = R_{oc} C_{oc}$;
3) $f_B = 1/R_{oc} C_{oc}$,

где R_{oc} и C_{oc} - сопротивление и емкости элементов цепи обратной связи.

14. Какой из АЦП является наиболее быстродействующим:

- 1) последовательного счета;
2) поразрядного кодирования;
3) параллельный.

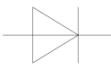
Тест

к Диф.зачёту по дисциплине “ “ Основы электротехники и блоки питания»

Вариант 7

1. Параметры полупроводниковых диодов, указываемые в конкретных случаях, это:
1) основные;
2) предельно-допустимые;
3) частные (для конкретных диодов).

2. Условное графическое обозначение туннельного диода:

- 1)  ;
2)  ;
3)  .

3. Какое из перечисленных свойств определяет область применения светодиодов:

- 1) наличие емкости;
2) явление пробоя;
3) чувствительность к внешним воздействиям;
4) свечение при протекании электрического тока.

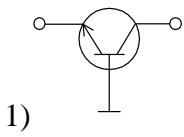
4. Вольтамперная характеристика полупроводникового диода описывает взаимосвязь

- 1) тока, протекающего через диод с напряжением, приложенным к нему;
2) емкости р-п-перехода и тока, протекающего через диод;
3) емкости р-п-перехода и напряжения, приложенного к диоду.

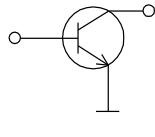
5. Биполярный транзистор содержит:

- 1) не менее трех выводов;
2) не менее двух выводов;
3) не менее четырех выводов.

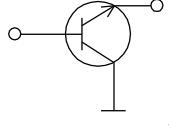
6. Схема включения БТ с ОБ:



1)



2)



3)

7. Физический смысл параметра R_i :

- 1) внутреннее (дифференциальное) сопротивление;
- 2) крутизна характеристики передачи;
- 3) статический коэффициент усиления по напряжению.

8. Эммитреный и коллекторный переходы биполярного транзистора открыты. В каком режиме работает транзистор:

- 1) режиме насыщения;
- 2) режиме отсечки;
- 3) нормальном активном режиме;
- 4) инверсном активном режиме.

9. Передаточная характеристика КМОП-элемента близка к идеальной. К какому достоинству это приводит:

- 1) большая помехоустойчивость;
- 2) нулевая мощность потребления в статическом режиме;
- 3) большая нагрузочная способность.

10. АЧХ усилителя называют зависимостью:

- 1) модуля комплексного коэффициента усиления от частоты;
- 2) выходного напряжения от частоты;
- 3) коэффициента усиления от фазы.

11. Отрицательная обратная связь:

- 1) увеличивает;
 - 2) оставляет неизменным;
 - 3) уменьшает
- полосу пропускания усилителя.

12. Выходное сопротивление неинвертирующего усилителя на ОУ равно:

- 1) выходному сопротивлению $R_{\text{вых}} \text{ ou}$;
- 2) $R_{\text{вых}} / (1 + \beta K)$;
- 3) $R_{\text{вых}} / \beta K$.

13. Верхняя граничная частота активного ФНЧ:

- 1) $f_B = 1/(2\pi R_{oc} C_{oc})$;
- 2) $\omega_B = R_{oc} C_{oc}$;
- 3) $f_B = 1/R_{oc} C_{oc}$,

где R_{oc} и C_{oc} - сопротивление и емкости элементов цепи обратной связи.

14. Основой многих интегральных ЦАП является ЦАП:

- 1) на матрице резисторов с весовыми сопротивлениями;
- 2) на матрице $R-2R$;
- 3) на матрице ПЗС.

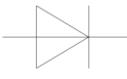
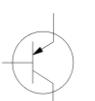
Тестовые задания
к диф. Зачету по дисциплине “Основы электротехники и блоки питания”

Вариант 1

1. Полупроводниковый диод это:

- 1) полупроводниковый прибор с двумя р-п-переходами, имеющий три вывода;
- 2) полупроводниковый прибор с одним электронно-дырочным переходом, имеющий два вывода;
- 3) полупроводниковый прибор с одним электронно-дырочным переходом, имеющий три и более выводами.

2. Условное графическое обозначение стабилитрона:

- 1)  ;
- 2)  ;
- 3)  .

3. При прямом включении р-п-перехода запирающий слой:

- 1) исчезает;
- 2) расширяется;
- 3) не изменяется.

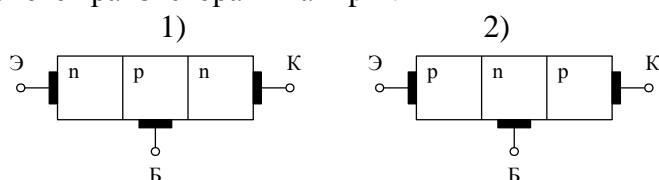
4. Туннельный пробой возникает:

- 1) в широких переходах с незначительной концентрацией примесей;
- 2) в узких переходах с большой концентрацией примесей;
- 3) в узких переходах с незначительной концентрацией примесей;
- 4) в широких переходах с большой концентрацией примесей.

5. Основное назначение биполярного транзистора:

- 1) ограничение электрических сигналов;
- 2) усиление электрических сигналов;
- 3) переключение электрических сигналов.

6. Структура биполярного транзистора типа п-р-п:



7. Физический смысл параметра h_{12} :

- 1) коэффициент обратной передачи по напряжению;
- 2) выходная проводимость;
- 3) коэффициент прямой передачи по току;
- 4) входное сопротивление.

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К АТТЕСТАЦИИ.

Основная литература

1. Электротехника и электроника: учебник для сред. проф.образования / М.В. Немцов, М. Л. Немцова. - 3-е изд., испр. - М, Академия, 2020. – 480 с.;
2. Электротехника В.М. Прошин.- М., Издательский центр Академия, 2020 г

Дополнительная литература

Электрические машины: учебник для сред. проф.образования / М.М. Кацман. – 13-е изд., стер.-М., Академия, 2020. – 496 с..

Интернет-ресурсы

1. Электротехника и электроника. - Режим доступа: <http://studfile.net>
2. Электротехника и электроника. - Режим доступа: <http://obuchalka.org>
3. Блоки питания. - Режим доступа: <http://studfile.net>